УДК 544.542.2; 577.34

#### Огурцов А.Н., Близнюк О.Н., Масалитина Н.Ю.

## МОДЕЛИРОВАНИЕ МАТРИЧНО-АКТИВИРОВАННОГО ПЕРЕНОСА ЭНЕРГИИ К ПРИМЕСНЫМ ЦЕНТРАМ В ТЕХНОЛОГИИ МОДИФИКАЦИИ МАТЕРИАЛОВ ЭЛЕКТРОННЫМИ ВОЗБУЖДЕНИЯМИ

**Постановка и актуальность задачи.** Проблема управления процессами переноса энергии к примесным центрам является ключевой в радиационных технологиях управляемой модификации свойств материалов [1]. Именно эффективность матрично-активированного переноса энергии определяет результативность как таких аналитических методик, как матрично-активированная лазерная десорбция/ионизация (MALDI, Matrix Assisted Laser Desorption/Ionization) [2], усиленная поверхностью лазерная десорбция/ионизация (SELDI, Surface-Enhanced Laser Desorption/Ionization) [3], матрично-активированная спектроскопия, лимитированная диффузией (MAD, Matrix-Assisted Diffusion-Ordered Spectroscopy (DOSY)) [4], так и таких современных селективных методик модификации биоматериалов, как лазерная антираковая фотодинамическая терапия (PDT, Photodynamic Therapy) с использованием наночастиц [5].

Особую роль матрично-активированный перенос энергии к реакционным центрам играет в методиках матричной изоляции [6], в частности, в спектроскопии матричной изоляции [7] и в физико-химических исследованиях матрично-изолированных молекул [8]. В качестве матриц в такого рода исследованиях преимущественно используют атомарные криокристаллы инертных элементов [9], которые, как было показано недавно, являются активными участниками физико-химических реакций в матрично-изолированных объектах [10]. При этом наблюдаются процессы комплексообразования молекулы примеси с близлежащими атомами матрицы [11], что и определяет динамику релаксации матрично-изолированных центров [12]. Поскольку при любом способе возбуждения матрицы пучками частиц высоких энергий все высоковозбуждённые состояния конденсированной системы за время  $10^{-13}$ – $10^{-10}$  с релаксируют с преимущественным образованием вторичных электронов, то особенности процессов матрично-активированного переноса энергии к матрично-изолированным центрам определяются именно динамикой релаксации вторичных электронов и возбуждаемых ими экситонов, которые и являются основными переносчиками энергии электронного возбуждения в матрице.

В настоящей работе моделирование процессов матрично-активированного переноса энергии к матрично-изолированным центрам проведено на простейших модельных системах двухатомных гомо- (N<sub>2</sub>) и гетероатомных (CO) примесных молекул, матрично-изолированных в атомарных криокристаллах криптона и аргона.

Эксперимент. Для изучения процессов переноса энергии электронного возбуждения мы использовали селективное возбуждение импульсным синхротронным излучением на светосильной установке SUPERLUMI, которая была смонтирована на канале I накопительного кольца DORIS-III Гамбургской синхротронной лаборатории HASYLAB Международного синхротронного центра DESY в Германии. Фотолюминесценция исследовалась при селективном фотовозбуждении первичным монохроматором со спектральным разрешением  $\Delta \lambda = 0,25$  нм в вакуумном ультрафиолете в диапазоне энергий фотонов 5– 40 эВ и регистрации люминесценции вторичным монохроматором со спектральным разрешением  $\Delta \lambda = 0,2$  нм в диапазоне энергий фотонов 4–45 эВ. Экспериментальная установка и методы выращивания образцов подробно описаны в работе [13]. Концентрация примеси в образцах составляла 0,1 ат.%.

**Результаты и обсуждение.** Спектр фотолюминесценции криокристаллов криптона, допированных  $N_2$ , при возбуждении образца фотонами с энергиями hv = 21,7 эВ и hv = 23,7 эВ приведён на рис. 1(а).

В области энергий 4–7,5 эВ расположена система полос, формируемая главным образом переходами  $(A^{3}\Sigma_{u}^{+},v'') \rightarrow (X^{1}\Sigma_{g}^{+},v')$  для v'' = 1 и 2 в молекуле N<sub>2</sub>, соответствующие полосам Вегарда-Каплана в свечении газообразного азота [10]. Широкая полоса с максимумом на 8,4 эВ является полосой *М* люминесценции автолокализованных квазимолекулярных экситонов кристаллического криптона [13]. Видно, что эффективность возбуждения примесной люминесценции по отношению к люминесценции автолокализованных экситонов фотонами с энергиями hv = 21,7 эВ вдвое выше, чем фотонами с энергиями hv = 23,7 эВ.

На рис. 1(б) приведён спектр возбуждения люминесценции полосы (0-3) Вегарда-Каплана 5,27 эВ, в котором можно выделить три части. В диапазоне от 5,5 эВ до начала экситонного поглощения матрицей криптона ( $E_1^{\text{Kr}} = 10,14$  эВ – энергетическое положение дна нижайшей  $\Gamma(3/2)$ , n = 1 экситонной зоны в твёрдом Kr [13]) происходит прямое возбуждение примесной молекулы азота возбуждающими фотонами. Поскольку концентрация примеси составляла 0,1 ат.%, то эффективность прямого возбуждения примеси фотонами была достаточно низкой.



Рисунок 1 – Спектры кристалла криптона с примесью N<sub>2</sub> при T = 7 К: a – спектр фотолюминесценции, при возбуждении фотонами с энергией hv = 21,7 эВ (сплошная линия) и hv = 23,7 эВ (пунктир);  $\delta$  – спектр возбуждения полосы (0-3) Вегарда-Каплана 5,27 эВ

При повышении энергии фотонов выше  $E_1^{\text{Kr}}$  и до энергии запрещённой зоны  $E_g^{\text{Kr}} = 10,61$  эВ [13] (в экситонной области спектра) происходит возбуждение свободных экситонов в матрице Kr, которые, распространяясь по кристаллу, переносят энергию возбуждения к примесным молекулам азота и возбуждают их. Это проявляется в спектре возбуждения на рис. 1(б) в виде полосы области  $E_1^{\text{Kr}} - E_g^{\text{Kr}}$ , структура которой определяется экситонным спектром поглощения твёрдого Kr.

При дальнейшем повышении энергии фотонов эффективность переноса энергии к примесным молекулам азота резко падает при  $E_g^{Kr}$  и начинает расти только выше энергии  $E_2^{Kr} = 17,5$  эВ, когда в результате неупругого рассеяния фотоэлектронов возбуждается молекула примеси, а у фотоэлектрона остаётся ещё достаточно энергии, чтобы возбудить вторую молекулу примеси. Такое увеличение эффективности возбуждения матрично-изолированных молекул N<sub>2</sub> наблюдается в спектре возбуждения люминесценции в виде широкой полосы с максимумом при 21,7 эВ. Очевидно, что именно в области энергий фотонов 20–24 эВ матрично-активированный перенос энергии к матрично-изолированным молекулам N<sub>2</sub> в матрице Kr происходит наиболее эффективно.

На рис. 2 приведены аналогичные спектры люминесценции и возбуждения люминесценции молекул СО в матрице Ar.



Рисунок 1 – Спектры кристалла аргона с примесью СО при T = 7 К: a – спектр фотолюминесценции, при возбуждении фотонами с энергией hv = 14,2 эВ;  $\delta$  – спектр возбуждения полосы Камерона 5,65 зВ

В области энергий 5–6 эВ расположена система узких полос, формируемых переходами  $(a^{3}\Pi,v^{"}) \rightarrow (X^{1}\Sigma^{+},v^{'})$  для  $v^{"} = 0$  и  $v^{'} = 0,1,2$  в матрично-изолированных молекулах CO, которые соответствуют система полос Камерона в излучении газообразного CO [15]. В случае матрично-изолированных молекул CO в матрице аргона система полос Камерона частично перекрывается широкой полосой H люминесценции аргоновой матрицы с максимумом при 6,2 эВ. Полоса H формируется переходами в молекулярных ионах из состояний  $(Ar_{2}^{+})^{*}$  (асимптотически соответствующих основному состоянию иона  $Ar^{+}$  и возбуждённому состоянию атома  $Ar^{+}({}^{3}P_{1,2}))$  в состояния  $Ar_{2}^{+}$  (асимптотически соответствующие основным состояния иона  $Ar^{+}$  и атома Ar) [10]. Широкая полоса с максимумом на 9,8 эВ является полосой M люминесценции автолокализованных квазимолекулярных экситонов твёрдого аргона [13].

На рис. 2(б) представлен спектр возбуждения полосы  $a^3\Pi (v'=0) \rightarrow X^1\Sigma^+(v''=1)$  матричноизолированных молекул CO ( $E_{\mu_{3,1}} = 5,65$  эВ). Так же, как и для системы N<sub>2</sub> в криптоне, в спектре возбуждения СО в аргоне можно выделить три части. В диапазоне энергий от 6 эВ до начала экситонного поглощения матрицей Ar происходит прямое возбуждение примесной молекулы СО возбуждающими фотонами. Энергетическое положение дна нижайшей  $\Gamma(3/2)$ , n = 1 экситонной зоны в твёрдом аргоне  $E_1^{\rm Ar} = 12,06$  эВ [13]. Так же как и в случае N<sub>2</sub>/Kr эффективность прямого возбуждения примеси фотонами была достаточно низкой.

При повышении энергии фотонов в экситонной области спектра начиная от  $E_1^{\text{Ar}}$  и до энергии запрещённой зоны  $E_g^{\text{Ar}} = 14,16$  эВ [13] происходит возбуждение свободных экситонов в матрице Ar, которые, распространяясь по кристаллу, переносят энергию возбуждения к примесным молекулам CO и возбуждают их. Это проявляется в спектре возбуждения на рис. 2(б) в виде набора пиков в области  $E_1^{\text{Ar}} - E_g^{\text{Ar}}$ , структура которого определяется экситонным спектром поглощения твёрдого Ar.

При дальнейшем повышении энергии фотонов эффективность переноса энергии к примесным молекулам СО снижается при  $E_g^{Ar}$  и начинает расти только выше энергии  $E_2^{Ar} = 21$  эВ, когда в результате неупругого рассеяния фотоэлектронов возбуждается молекула примеси, а у фотоэлектрона остаётся ещё достаточно энергии, чтобы возбудить вторую молекулу примеси. Такое увеличение эффективности возбуждения матрично-изолированных молекул СО наблюдается в спектре возбуждения люминесценции в виде широкой полосы с максимумом при 25 эВ. Очевидно, что именно в области энергий фотонов 24–27 эВ матрично-активированный перенос энергии к матрично-изолированным молекулам СО в матрице Ar происходит наиболее эффективно.

Таким образом, матрично-активированный перенос энергии как для случая гомо- (N<sub>2</sub>), так и для случая гетероатомных (CO) примесных двухатомных молекул, матрично-изолированных в атомарных криокристаллах инертных элементов, наиболее эффективен в области неупругого рассеяния фотоэлектронов матрицы, сопровождающегося мультипликацией электронных возбуждений. Возбуждающий фотон с энергией выше пороговой энергии  $E > E_2$  создаёт электрон-дырочную пару. Горячий фотоэлектрон может рассеяться неупруго на примесной молекуле с переходом в состояние с меньшей энергией, находясь в котором он имеет все ещё достаточно энергии, чтобы возбудить ещё одну молекулу примеси. Результатом этого процесса мультипликации электронных возбуждений является существенное увеличение интенсивности излучения примеси при  $E > E_2$ . Снижение эффективности переноса энергии к молекулам примеси при энергиях фотовозбуждения выше 22 эВ в случае системы N<sub>2</sub>/Kr и выше 25 эВ в случае CO/Ar происходит вследствие увода горячих фотоэлектронов в канал релаксации, связанный с генерацией вторичных экситонов в процессах электрон-электронного и электрон-фононного рассеяния горячих электронов в зоне проводимости. В этом случае система кинетических уравнений для концентраций электронов  $n_e$ , дырок  $n_h$  и экситонов  $n_{ex}$  имеет вид

$$\frac{\mathrm{d}n_{\mathrm{e}}(t)}{\mathrm{d}t} = G(t) - \sigma(T_{\mathrm{e}})n_{\mathrm{e}}(t)n_{\mathrm{h}}(t)v_{\mathrm{rel}}(T_{\mathrm{e}}) - \frac{n_{\mathrm{e}}(t)}{\tau_{\mathrm{nr}}},$$

$$\frac{\mathrm{d}n_{\mathrm{h}}(t)}{\mathrm{d}t} = G(t) - \sigma(T_{\mathrm{e}})n_{\mathrm{e}}(t)n_{\mathrm{h}}(t)v_{\mathrm{rel}}(T_{\mathrm{e}}),$$

$$\frac{\mathrm{d}n_{\mathrm{ex}}(t)}{\mathrm{d}t} = \sigma(T_{\mathrm{e}})n_{\mathrm{e}}(t)n_{\mathrm{h}}(t)v_{\mathrm{rel}}(T_{\mathrm{e}}) - \frac{n_{\mathrm{ex}}(t)}{\tau_{\mathrm{rad}}}.$$
(1)

Здесь  $T_{\rm e}$  – электронная температура;  $v_{\rm rel}(T_{\rm e}) = \sqrt{\frac{8kT_{\rm e}}{\pi\mu}}$  – относительная скорость электрон-дырочной пары; G(t) – скорость генерации электрон-дырочных пар (интенсивность возбуждения);  $\tau_{\rm rad}$  – радиационное время экситонной люминесценции;  $\tau_{\rm nr}$  – время безызлучательного захвата электронов ловушками;  $\mu = \frac{m_{\rm e}m_{\rm h}}{m_{\rm e}+m_{\rm h}}$  – приведённая масса экситона;  $m_{\rm e}$  и  $m_{\rm h}$  – эффективные массы электрона и дырки, соответст-

венно [13]. Сечение захвата электрона дыркой имеет вид

$$\sigma(T_{\rm e}) = \frac{16\sqrt{2}e^{6}E_{\rm d}^{2}}{3\sqrt{3\pi}\hbar^{4}s\rho\varepsilon_{0}^{3}\varepsilon_{\rm r}^{3}} \cdot \frac{m_{\rm e}^{3}m_{\rm h}}{\left(m_{\rm h} + m_{\rm e}\right)^{1.5}} \cdot \frac{1}{\sqrt{kT_{\rm L}}\left(kT_{\rm e}\right)^{2}},\tag{2}$$

где *s* – скорость звука;  $E_{\rm d}$  – деформационный потенциал;  $\varepsilon_0$  – диэлектрическая постоянная;  $\varepsilon_{\rm r}$  – диэлектрическая проницаемость;  $\rho$  – плотность; *e* – элементарный заряд; *k* – константа Больцмана;  $T_{\rm L}$  – температура кристалла (решётки).

Теоретически процесс неупругого рассеяния электронов был рассмотрен в работе [16]. В рамках этой теории, которая рассматривает переход между двумя параболическими энергетическими зонами, пороговая энергия мультипликации электронных возбуждений при неупругом рассеянии фотоэлектронов определяется как

$$E_{\rm th} = E_{\rm th}^0 \pm 2\Lambda \sqrt{E_{\rm Q}} \sqrt{(1+\Lambda)(E_{\rm g}+\Lambda E_{\rm Q})} + \Lambda(1+2\Lambda)E_{\rm Q}, \qquad (3)$$

где  $\Lambda = \frac{m_{\rm e}}{m_{\rm e} + m_{\rm h}}; E_{\rm Q} = \frac{\hbar^2 Q^2}{2m_{\rm e}}; Q$  – сдвиг между параболическими зонами в обратном пространстве.

В случае атомарных криокристаллов инертных элементов экстремумы энергетических зон находятся в  $\Gamma$ -точке зоны Бриллюэна, что определяет Q = 0, и пороговая энергия образования вторичной электрондырочной пары может быть оценена по формуле

$$E_{\rm th} = (1 - \Lambda)E_{\rm g} = E_{\rm g} + E_{\rm g} \cdot \left(1 + \frac{m_{\rm e}}{m_{\rm h}}\right),\tag{4}$$

где *m*<sub>e</sub> и *m*<sub>h</sub> – эффективные массы электрона и дырки, соответственно. Для оценки пороговой энергии мультипликации возбуждения матрично-изолированных примесных молекул фотоэлектронами матрицы можно использовать аналогичное соотношение

$$E_{\rm th}^{\rm i} = E_{\rm g} + E_{\rm i} \cdot \left(1 + \frac{m_{\rm e}}{m_{\rm h}}\right),\tag{5}$$

где  $E_i$  – энергия нижайшего электронного перехода в матрично-изолированной молекуле. Для случаев CO/Ar и N<sub>2</sub>/Kr соответствующие энергии равны  $E_i^{CO} = 5,96$  эВ [15] и  $E_i^{N_2} = 6,14$  эВ [17].

Используя формулу (5) и следующие значения эффективных масс электронов и дырок  $m_{\rm e}({\rm Ar}) = 0,48 \cdot m_0; m_{\rm h}({\rm Ar}) = 5,3 \cdot m_0; m_{\rm e}({\rm Kr}) = 0,42 \cdot m_0; m_{\rm h}({\rm Kr}) = 3,6 \cdot m_0$  [18] ( $m_0$  – масса покоя свободного электрона), получаем значения пороговых энергий мультипликации возбуждения матрично-изолированных примесных молекул фотоэлектронами матрицы  $E_{\rm th}^{\rm CO} = 20,66$  эВ и  $E_{\rm th}^{\rm N_2} = 17,46$  эВ, которые близки к экспериментально измеренным значениям  $E_2$ .

Выводы. Таким образом, на модельных системах экспериментально исследованы процессы переноса энергии матрицами атомарных криокристаллов криптона и аргона к двухатомным примесным молекулам  $N_2$  и СО. Выделены три энергетических диапазона фотонных энергий возбуждения системы матрицапримесь, различающиеся механизмами заселения примесных возбуждённых молекулярных состояний. В рамках упрощённой теории, которая рассматривает переход между двумя параболическими энергетическими зонами, получены значения пороговых энергий мультипликации возбуждения матрично-изолированных примесных молекул  $N_2$  и СО фотоэлектронами матриц криптона и аргона, соответственно. Экспериментально определены диапазоны энергий фотовозбуждения исследованных модельных матрично-изолированных систем, в которых наиболее эффективно функционирует канал переноса энергии электронного возбуждения к примесным центрам, что позволяет установить технологические параметры облучения образцов в радиационной технологии модификации материалов электронными возбуждениями.

### Литература

1. Itoh N. Materials Modification by Electronic Excitation / N. Itoh, M. Stoneham. – Cambridge : University Press, 2000. – 536 p.

2. MALDI Mass Spectrometry for Synthetic Polymer Analysis / Ed. by Liang Li. – John Wiley & Sons, Inc. : Hoboken, 2010. – 299 p.

3. SELDI-TOF Mass Spectrometry: Methods and Protocols / Ed. by C.H. Clarke, D.L.B. McCarthy. – Humana Press : New York, 2012. – 239 p. 4. Tormena C.F. Matrix-assisted Diffusion-ordered Spectroscopy: Mixture Resolution by NMR using SDS Micelles / C.F. Tormena, R. Evans, S. Haiber, M. Nilsson, G.A. Morris // Magnetic Resonance Chemistry. – 2010. – V. 48, № 7. – P. 550–553.

5. El-Sayed I.H. Selective Laser Photo-thermal Therapy of Epithelial Carcinoma Using anti-EGFR Antibody Conjugated Gold Nanoparticles / I.H. El-Sayed, X. Huang, M.A. El-Sayed // Cancer Letters. – 2006. – V. 239, № 1. – P. 129–135.

6. Bally T. Matrix Isolation / In: R.A. Moss, M.S. Platz, M. Jones (eds.), Reactive Intermediate Chemistry. – John Wiley & Sons, Inc. : Hoboken, 20004. – P. 797–845.

7. Matrix Isolation Spectroscopy / Ed. by A. Barnes, W.J. Prville-Thomas, A. Muller. – Springer : Berlin, 1981. – 615 p.

8. Chemistry and Physics of Matrix-Isolated Species / Ed. by L. Andrews, M. Moscovitz. – North Holland Publishing Company : Amsterdam, 1989. – 438 p.

9. Physics and Chemistry at Low Temperatures / Ed. by L. Khriachtchev. – Pan Stanford Publishing Pte. Ltd. : Singapore, 2011. – 536 p.

10. Ogurtsov A.N. Advances in Spectroscopy of Subthreshold Inelastic Radiation-Induced Processes in Cryocrystals / In: E.C. Faulques, D.L. Perry, A.V. Yeremenko (eds.), Spectroscopy of Emerging Materials. – Dordrecht : Kluwer Academic Publishers, 2004. – P. 45–56.

11. Anderson D.T. Infrared Spectrum of Matrix-Isolated CO and CO Photoproduct from OCS Photolysis / D.T. Anderson, J.S. Winn // Journal of Physical Chemistry A. – 2000. – V. 104, №16. – P. 3472–3480.

12. Apkarian V.A. Molecular Photodynamics in Rare Gas Solids / V.A. Apkarian, N. Schwentner // Chemical Reviews. – 1999. – V. 99, № 6. – P. 1481–1514.

13. Огурцов А.Н. Модификация криокристаллов электронными возбуждениями: монография / А.Н. Огурцов. – Харьков : НТУ "ХПИ", 2009. – 368 с.

14. Semling M. Luminescence Spectra of Matrix Isolated N<sub>2</sub> at High Pressure and Low Temperature / M. Semling, M. Jordan, K. Syassen, H.J. Jodl, G.F. Signorini // Journal of Chemical Physics. – 1997. – V. 106,  $N_{2}$  4. – P. 1336–1345.

15. Bahrdt J. Triplet States of CO Trapped in Rare Gas Crystals / J. Bahrdt, P. Gurtler, N. Schwentner // Journal of Chemical Physics. – 1987. – V. 86, № 11. – P. 6108–6114.

16. Vasil'ev A.N. Impact Production of Secondary Electronic Excitations in Insulators: Multiple-parabolicbranch Band Model / A.N. Vasil'ev, F. Fang, V.V. Mikhailin // Physical Review B. – 1999. – V. 60, № 8. – P. 5340–5347.

17. Pan S.L. Vibrational Relaxation in the  $A^{3}\Sigma i^{+}_{u}$  State of  $N_{2}$  in Rare Gas Matrices / S.L. Pan, G. Zumofen, K. Dressler // Journal of Chemical Physics. – 1987. – V.87, No 6. – P. 3482–3491.

18. Kisand V. An Analysis of Electron-hole Recombination in Solid Krypton Using Time-resolved VUVluminescence Spectroscopy / V. Kisand, M. Kirm, S. Vielauer, G. Zimmerer // Surface Review and Letters. – 2002. – V. 9, № 2. – P. 783–788.

### Bibliography (transliterated)

1. Itoh N. Materials Modification by Electronic Excitation N. Itoh, M. Stoneham. – Cambridge : University Press, 2000. – 536 p.

2. MALDI Mass Spectrometry for Synthetic Polymer Analysis Ed. by Liang Li. – John Wiley & Sons, Inc. : Hoboken, 2010. – 299 p.

3. SELDI-TOF Mass Spectrometry: Methods and Protocols Ed. by C.H. Clarke, D.L.B. McCarthy. – Humana Press : New York, 2012. – 239 p.

4. Tormena S.F. Matrix-assisted Diffusion-ordered Spectroscopy: Mixture Resolution by NMR using SDS Micelles C.F. Tormena, R. Evans, S. Haiber, M. Nilsson, G.A. Morris Magnetic Resonance Chemistry. – 2010. – V. 48, # 7. – P. 550–553.

5. El-Sayed I.H. Selective Laser Photo-thermal Therapy of Epithelial Carcinoma Using anti-EGFR Antibody Conjugated Gold Nanoparticles I.H. El-Sayed, X. Huang, M.A. El-Sayed Cancer Letters. – 2006. – V. 239, # 1. – P. 129–135.

6. Bally T. Matrix Isolation In: R.A. Moss, M.S. Platz, M. Jones (eds.), Reactive Intermediate Chemistry. – John Wiley & Sons, Inc. : Hoboken, 20004. – P. 797–845.

7. Matrix Isolation Spectroscopy Ed. by A. Barnes, W.J. Prville-Thomas, A. Muller. – Springer : Berlin, 1981. – 615 p.

8. Chemistry and Physics of Matrix-Isolated Species Ed. by L. Andrews, M. Moscovitz. – North Holland Publishing Company : Amsterdam, 1989. – 438 p.

9. Physics and Chemistry at Low Temperatures Ed. by L. Khriachtchev. – Pan Stanford Publishing Pte. Ltd. : Singapore, 2011. – 536 p.

10. Ogurtsov A.N. Advances in Spectroscopy of Subthreshold Inelastic Radiation-Induced Processes in Cryocrystals In: E.C. Faulques, D.L. Perry, A.V. Yeremenko (eds.), Spectroscopy of Emerging Materials. – Dordrecht : Kluwer Academic Publishers, 2004. – P. 45–56.

11. Anderson D.T. Infrared Spectrum of Matrix-Isolated CO and CO Photoproduct from OCS Photolysis D.T. Anderson, J.S. Winn Journal of Physical Chemistry A. – 2000. – V. 104, #16. – P. 3472–3480.

12. Apkarian V.A. Molecular Photodynamics in Rare Gas Solids V.A. Apkarian, N. Schwentner Chemical Reviews. – 1999. – V. 99, # 6. – P. 1481–1514.

13. Ogurcov A.N. Modifikacija kriokristallov jelektronnymi vozbuzhdenijami: monografija A.N. Ogurcov. – Har'kov : NTU "HPI", 2009. – 368 p.

14. Semling M. Luminescence Spectra of Matrix Isolated N2 at High Pressure and Low Temperature M. Semling, M. Jordan, K. Syassen, H.J. Jodl, G.F. Signorini Journal of Chemical Physics. – 1997. – V. 106, # 4. – P. 1336–1345.

15. Bahrdt J. Triplet States of CO Trapped in Rare Gas Crystals / J. Bahrdt, P. Gurtler, N. Schwentner // Journal of Chemical Physics. – 1987. – V. 86, # 11. – P. 6108–6114.

16. Vasil'ev A.N. Impact Production of Secondary Electronic Excitations in Insulators: Multiple-parabolicbranch Band Model A.N. Vasil'ev, F. Fang, V.V. Mikhailin Physical Review B. – 1999. – V. 60, # 8. – P. 5340–5347.

17. Pan S.L. Vibrational Relaxation in the A3Σi+u State of N2 in Rare Gas Matrices S.L. Pan, G. Zumofen, K. Dressler Journal of Chemical Physics. – 1987. – V.87, # 6. – P. 3482–3491.

18. Kisand V. An Analysis of Electron-hole Recombination in Solid Krypton Using Time-resolved VUVluminescence Spectroscopy V. Kisand, M. Kirm, S. Vielauer, G. Zimmerer Surface Review and Letters. – 2002. – V. 9, # 2. – P. 783–788.

УДК 544.542.2; 577.34

Огурцов О.М., Близнюк О.М., Масалітіна Н.Ю.

### МОДЕЛЮВАННЯ МАТРИЧНО-АКТИВОВАНОГО ПЕРЕНОСУ ЕНЕРГІЇ ДО ДОМІШКОВИХ ЦЕНТРІВ В ТЕХНОЛОГІЇ МОДИФІКАЦІЇ МАТЕРІАЛІВ ЕЛЕКТРОННИМИ ЗБУДЖЕННЯМИ

На простих модельних системах двоатомних гомо- (N<sub>2</sub>) та гетероатомних (CO) домішкових молекул досліджені процеси матрично-активованого переносу енергії до матрично-ізольованих центрів в атомарних кріокристалах криптону та аргону. Визначені діапазони найбільш ефективного фотозбудження домішкових молекул електронними збудженнями матриці.

Ogurtsov A.N., Bliznjuk O.N., Masalitina N.Yu.

# MODELING OF MATRIX-ASSISTED ENERGY TRANSFER TO IMPURITIES IN TECHNOLOGY OF MATERIALS MODIFICATION BY ELECTRONIC EXCITATIONS

On the simple model systems of diatomic homo-  $(N_2)$  and heteroatomic (CO) impurity molecules the processes of matrix-assisted energy transfer to matrix-isolated centers in krypton and argon cryocrystals were studied. The energy ranges of most efficient photoexcitation of impurity molecules by electronic excitations of matrix were determined.